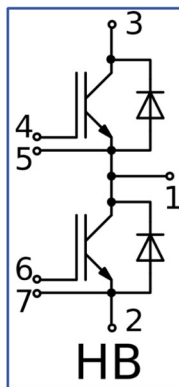
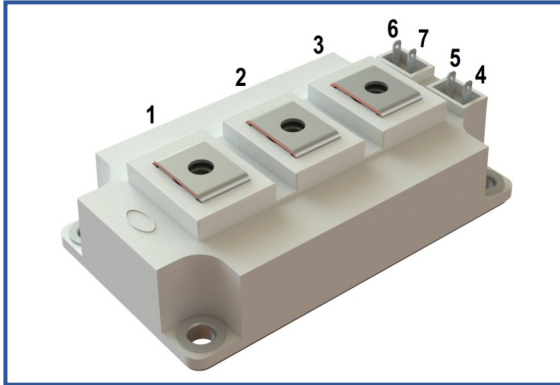


**IGBT модуль в стандартном корпусе 62мм**
**1200 В 300 А**


### Особенности чипов

- IGBT чип
  - Trench FS
  - низкое значение  $U_{CE(sat)}$
  - длительность КЗ 10 мкс при 150°C
  - квадратная область RBSOA при 2xIc
  - низкое ЭМИ
- FRD чип
  - быстрое и мягкое восстановление
  - низкое падение напряжения

### Особенности конструкции

- медное основание
- $Al_2O_3$  DBC подложки
- ультразвуковая приварка силовых выводов
- улучшенная стойкость к термоциклам
- соответствие RoHS

### Типовые применения

- приводы двигателей переменного тока
- преобразователи на основе солнечных батарей
- системы кондиционирования воздуха
- преобразователи высокой мощности и ИБП

## Предельно допустимые значения параметров

Параметр	Обозн.	Условия	Знач.	Ед.
<b>IGBT</b>				
Напряжение коллектор-эмиттер	$U_{CES}$	$U_{GE} = 0$ .	1200	В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	$I_{C 25}$	$T_{vj(max)} = 175^{\circ}C; T_C = 25^{\circ}C$ .	429	А
	$I_{C 80}$	$T_{vj(max)} = 175^{\circ}C; T_C = 80^{\circ}C$ .	300	А
Максимальный повторяющийся импульсный ток коллектора*1	$I_{CRM}$	$I_{CRM} = 2 \times I_{C nom}; t_p = 1 \text{ мс}$ .	600	А
Длительность импульсного тока короткого замыкания	$t_{psc}$	$T_{vj} = 25^{\circ}C; U_{GE} = \pm 15 \text{ В}; U_{CE} = 500 \text{ В}; R_{G on} = R_{G off} = 2.2 \text{ Ом}; I_{Cmax} < 1000 \text{ А}$ .	10	мкс
		$T_{vj} = 150^{\circ}C; U_{GE} = \pm 15 \text{ В}; U_{CE} = 500 \text{ В}; R_{G on} = R_{G off} = 2.2 \text{ Ом}; I_{Cmax} < 927 \text{ А}$ .	10	
Напряжение затвор-эмиттер	$U_{GES}$		$\pm 20$	В
Рабочая температура в области перехода кристалла	$T_{vj(op)}$		-40...+150	°C
<b>Диод чоппера/Обратно-параллельный диод.</b>				
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$	$U_{GE} = 0 \text{ В}$ .	1200	В
Максимально допустимый постоянный прямой ток	$I_{F 25}$	$T_{vj(max)} = 175^{\circ}C; T_C = 25^{\circ}C$ .	300	А
	$I_{F 80}$	$T_{vj(max)} = 175^{\circ}C; T_C = 80^{\circ}C$ .	224	А
Повторяющийся прямой импульсный ток*1	$I_{FRM}$	$I_{FRM} = 2 \times I_{F nom}; t_p = 1 \text{ мс}$ .	600	А
Рабочая температура перехода	$T_{vj(op)}$		-40...+150	°C
<b>Модуль</b>				
Температура хранения	$T_{stg}$		-40...+50	°C
Напряжение пробоя изоляции	$U_{isol}$	AC sin 50 Гц; t = 1 мин.	4000	В

\*1 Длительность импульса и частота повторения должна быть такой, чтобы температура перехода не превышала  $T_{vj max}$ .

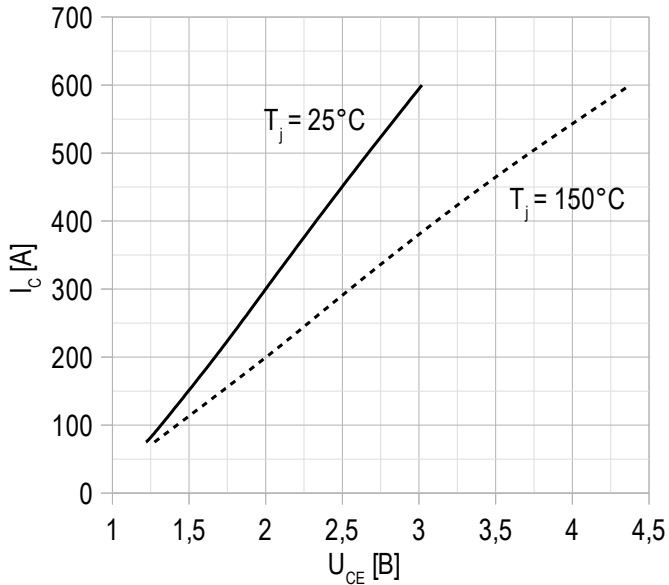
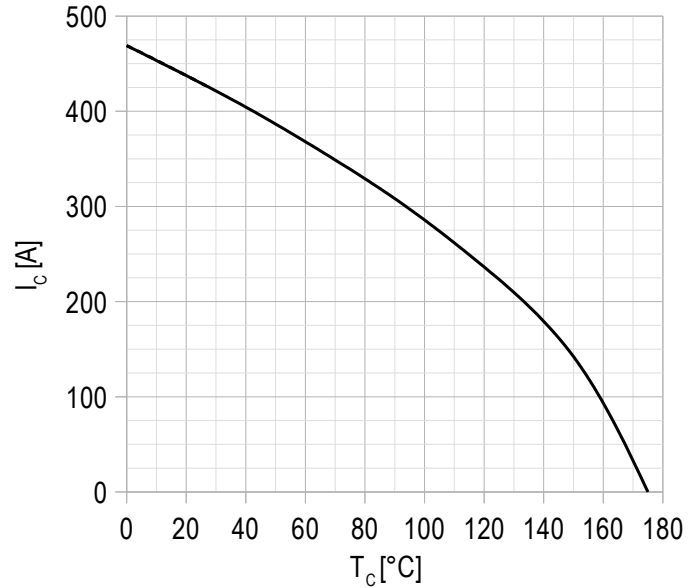
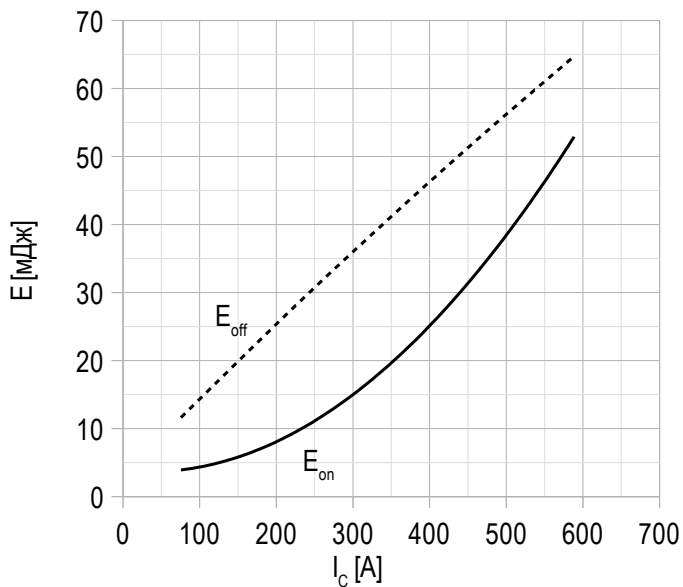
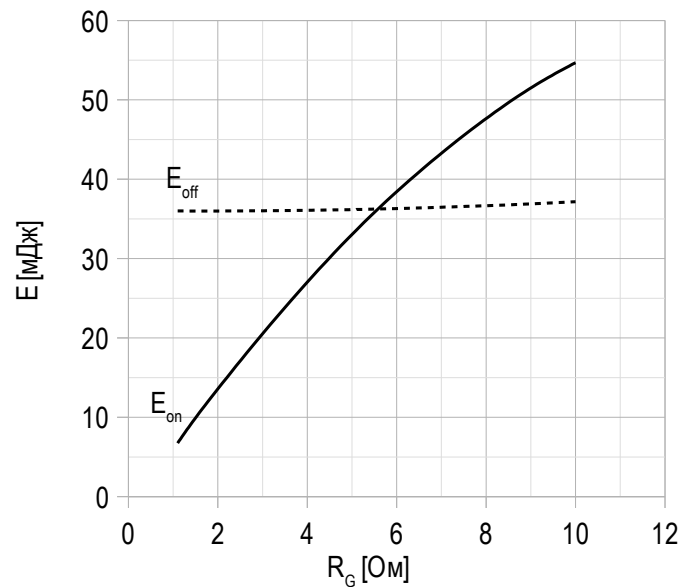
**Характеристики**

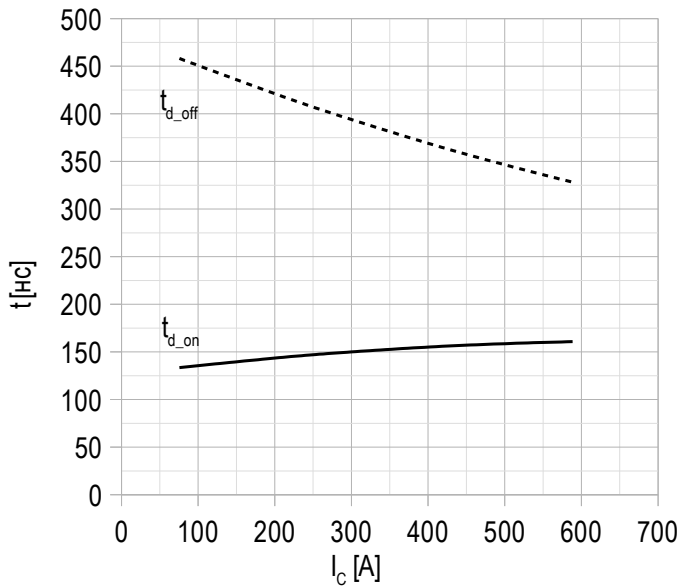
Параметр	Обозн.	Условия	Знач.			Ед.		
			мин.	тип.	макс.			
<b>IGBT</b>								
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{CEsat}$	$U_{GE} = +15\text{ В}; I_C = 300\text{ А}; t_u = 1000\text{ мкс.}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.75	2.00	2.25	В	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	2.25	2.55	2.85	В	
Пороговое напряжение затвор-эмиттер	$U_{GE(th)}$	$I_C = 12\text{ мА}; U_{CE} = U_{GE}; T_{vj} = 25^\circ\text{C}; t_u = 2\text{ мс.}$		5.30	5.90	6.50	В	
Ток утечки коллектор-эмиттер	$I_{CES}$	$U_{CE} = 1200\text{ В}; t_u = 50\text{ мс}; U_{GE} = 0.$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	-	15.0	100	мкА	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	-	10.0	20.00	мА	
Ток утечки затвор-эмиттер	$I_{GES}$	$U_{CE} = 0; U_{GE} = \pm 20\text{ В}; T_{vj} = 25^\circ\text{C}; t_u = 30\text{ мс.}$		-	13.0	100	нА	
Входная ёмкость	$C_{ies}$	$U_{CE} = 25\text{ В}; U_{GE} = 0\text{ В};$		-	27.50	-	нФ	
Обратная передаточная ёмкость	$C_{res}$	$f = 1\text{ МГц}; T_{vj} = 25^\circ\text{C}.$		-	0.85	-	нФ	
Заряд затвора	$Q_G$	$I_G = 20\text{ мА}; U_{CE} = 600\text{ В}; U_{GE} = -8...+15\text{ В}.$		-	1200	1300	нКл	
Встроенный резистор затвора	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}.$		-	1.70	-	Ом	
Время задержки включения	$t_{d(on)}$	$U_{CE} = 600\text{ В}; U_{GE} = \pm 15\text{ В}; I_{Cmax} = 300\text{ А}; R_G = 2.2\text{ Ом}; L_s = 56\text{ нГн}.$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	91	120	149	нс	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	120	150	180		
Время нарастания тока коллектора	$t_{ri}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	45	51	57	нс	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	48	55	62		
Энергия потерь при включении	$E_{on}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.00	5.5	10.0	мДж	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	7.0	15.0	23.0		
Время задержки выключения	$t_{d(off)}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	225	294	363	нс	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	345	394	443		
Время спада тока коллектора	$t_{fi}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	178	219	260	нс	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	233	269	305		
Энергия потерь при выключении	$E_{off}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	23.0	26.5	30.0	мДж	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	31.0	36.0	41.0		
Пороговое напряжение коллектор-эмиттер	$U_{CE0}$	$U_{GE} = +15\text{ В}; T_{vj} = 150^\circ\text{C}; I_{CE1} = 75\text{ А}; I_{CE2} = 300\text{ А}; t_u = 1000\text{ мкс.}$		0.79	0.84	0.89	В	
Динамическое сопротивление	$r_{CE0}$			5.26	5.62	5.98	МОм	
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_{th(j-c)}$	$DC; I_{CE} = 250 \pm 35\text{ А}; I_{test} = 1.0\text{ А}; U_{GE} = +15\text{ В}.$		-	0.083	0.101	К/Вт	
<b>Диод чоппера\Обратно-параллельный диод.</b>								
Постоянное прямое напряжение	$U_F$	$I_F = 300\text{ А}; U_{GE} = 0; t_u = 1000\text{ мкс.}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.85	2.25	2.65	В	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1.90	2.25	2.60	В	
Время обратного восстановления	$t_{rr}$	$U_{GE} = \pm 15\text{ В}; U_{CE} = 600\text{ В}; I_{Cmax} = 300\text{ А}; R_{Gon} = 2.2\text{ Ом}; L_s = 56\text{ нГн}.$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	98	115	132	нс	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	139	193	247	нс	
Импульсный обратный ток	$I_{RM}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	140	210	280	А	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	200	290	380	А	
Заряд восстановления	$Q_r$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	10.0	15.0	20.0	мкКл	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	22.5	31.0	39.5	мкКл	
Энергия потерь при обратном восстановлении	$E_{rec}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	5.0	9.0	13.0	мДж	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	13.0	21.0	29.0	мДж	
Пороговое напряжение	$U_{(T0)}$		$T_{vj} = 150^\circ\text{C}; U_{GE} = 0; I_{CE1} = 75\text{ А}; I_{CE2} = 300\text{ А}; t_u = 1000\text{ мкс}$		0.86	0.89	0.92	В
Динамическое сопротивление	$r_T$				4.28	4.58	4.88	МОм
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_{th(JC-D)}$		$DC; I_{CE} = 250 \pm 35\text{ А}; I_{test} = 1.0\text{ А}; U_{GE} = +15\text{ В}.$		-	0.178	0.210	К/Вт

Модуль							
Сопротивление выводов	$R_{Pxy}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}.$	$R_{P12}$	-	0.28	0.50	мОм
			$R_{P13}$	-	0.38	0.50	
Паразитная индуктивность модуля между силовыми выводами	$L_{Pce}$			-	22	-	нГн
Тепловое сопротивление корпус-охладитель	$R_{thCH}$	для модуля		-	0.02	0.04	К/Вт
Момент затягивания винтов корпуса	$M_s$	к охладителю М6		3.00	-	5.00	Н*м
Момент затягивания на силовых выводах	$M_t$	к клеммам М6		2.25	2.50	2.75	Н*м
Вес	$W$			-	320	340	г

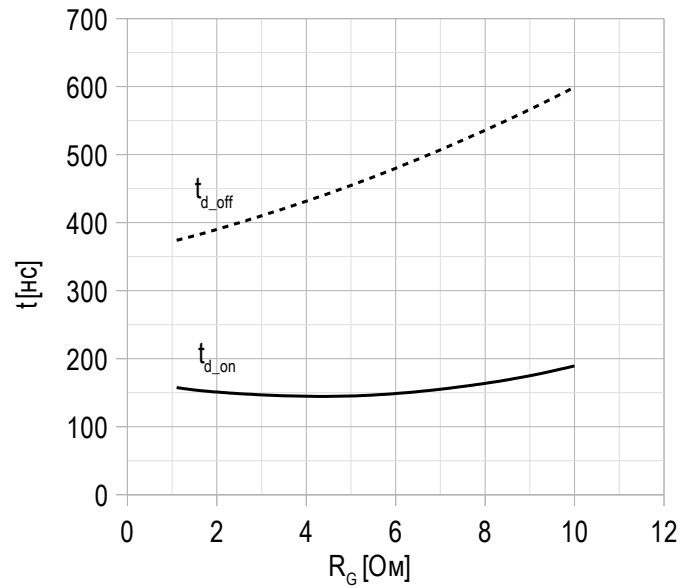
**Примечания:**

- Рабочая температура корпуса и изоляционных материалов не должна превышать  $T_c = 125^{\circ}\text{C}$  макс;
- Рекомендуемая рабочая температура кристалла  $T_{vj\text{ op}} = -40\dots+150^{\circ}\text{C}$

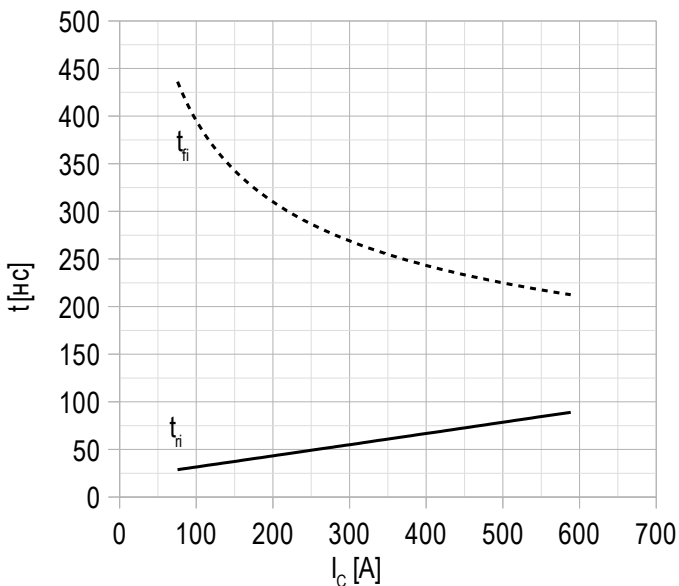
**Рисунок 1 – типичная выходная характеристика, IGBT.**

 $U_{GE} = +15 \text{ B.}$ 
**Рисунок 2 – максимальная зависимость тока коллектора от температуры корпуса.**

 Постоянный ток;  
 $U_{GE} = +15 \text{ B.}$   
 $T_{vj(max)} = 175^\circ\text{C.}$ 
**Рисунок 3 – типичная энергия переключения от тока коллектора, IGBT.**

 $U_{CE} = 600 \text{ B.}$   
 $U_{GE} = \pm 15 \text{ B.}$   
 $R_G = 2.2 \text{ Ом.}$   
 $L_s = 56 \text{ нГн.}$   
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C.}$ 
**Рисунок 4 – типичная энергия переключения от сопротивления в затворе, IGBT.**

 $U_{CE} = 600 \text{ B.}$   
 $U_{GE} = \pm 15 \text{ B.}$   
 $I_{Cmax} = 300 \text{ A.}$   
 $L_s = 56 \text{ нГн.}$   
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C.}$

**Рисунок 5 – типичное время переключения от тока коллектора, IGBT.**


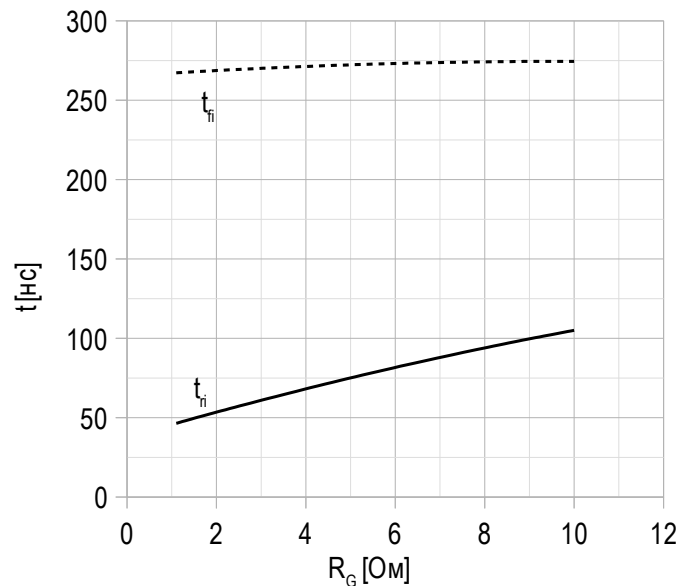
$U_{CE} = 600$  В;  
 $U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $R_G = 2.2$  Ом;  
 $L_s = 56$  нГн;  
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$ .

**Рисунок 6 – типичное время переключения от сопротивления в затворе, IGBT.**


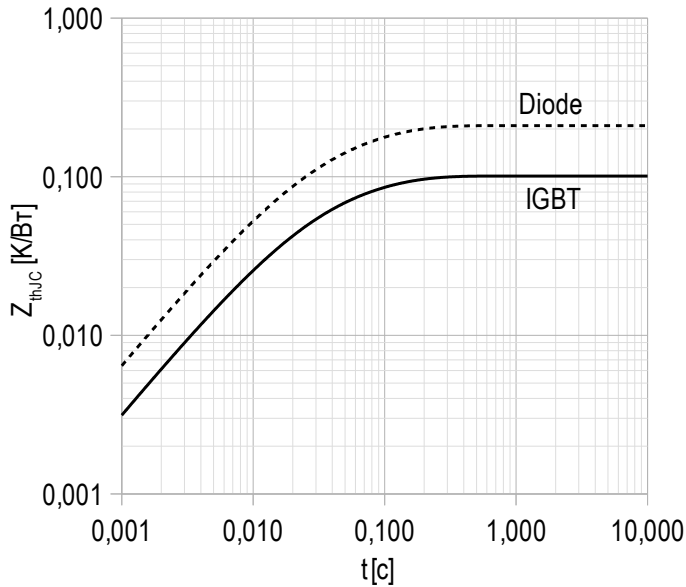
$U_{CE} = 600$  В;  
 $U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $I_{Cmax} = 300$  А;  
 $L_s = 56$  нГн;  
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$ .

**Рисунок 7 – типичное время переключения от тока коллектора, IGBT.**


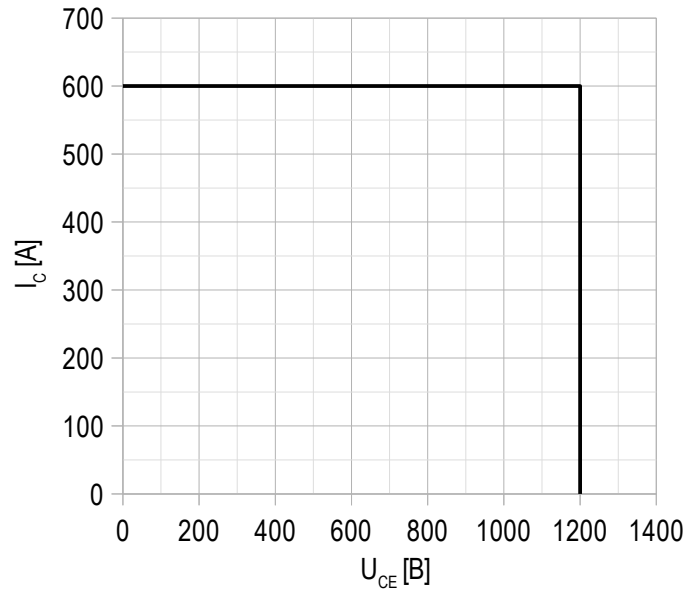
$U_{CE} = 600$  В;  
 $U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $R_G = 2.2$  Ом;  
 $L_s = 56$  нГн.  
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$ .

**Рисунок 8 – типичное время переключения от сопротивления в затворе, IGBT.**


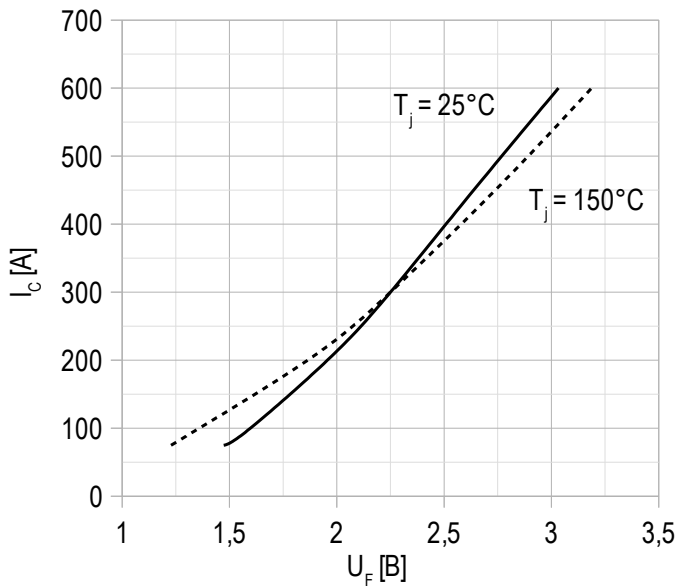
$U_{CE} = 600$  В;  
 $U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $I_{Cmax} = 300$  А;  
 $L_s = 56$  нГн.  
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$ .

**Рисунок 9 – максимальное переходное тепловое сопротивление.**


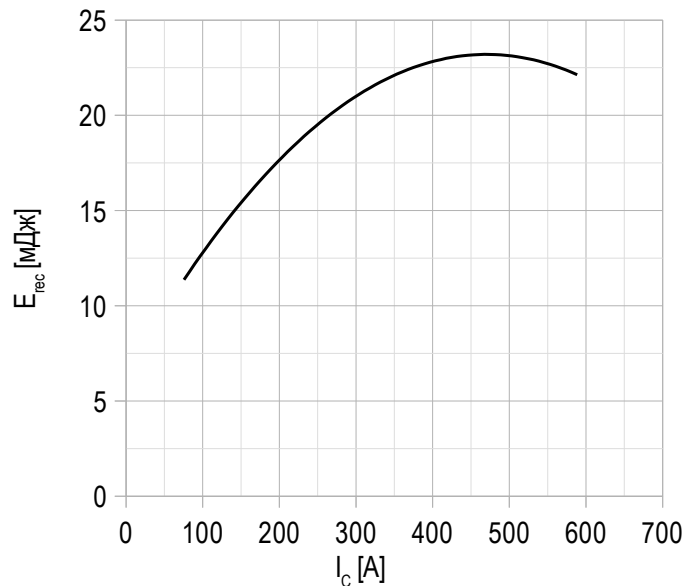
Единичный импульс;  
 $U_{GE} = +15$  В.

**Рисунок 10 – область безопасной работы при выключении.**


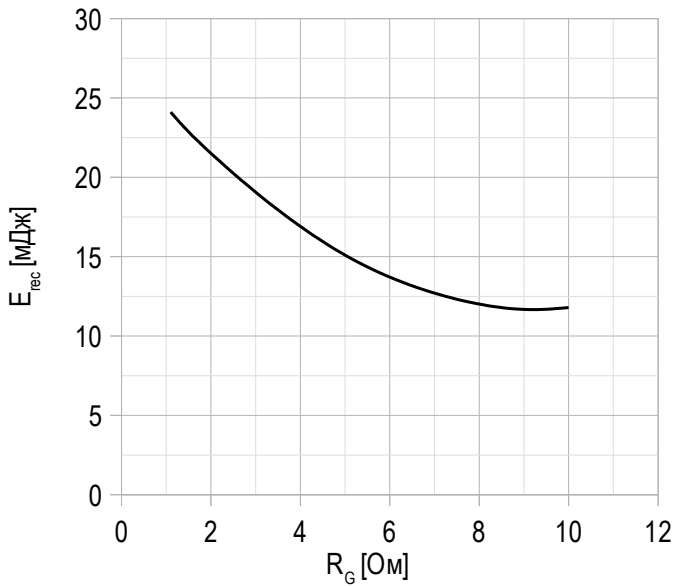
$U_{CE\ max} = 1200$  В;  
 $U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $I_{C\ max} = 2 * I_{C\ ном}$ ;  
 $R_G = 2.2$  Ом;  
 $L_s = 56$  нГн.

**Рисунок 11 – типичная прямая характеристика, FRD.**


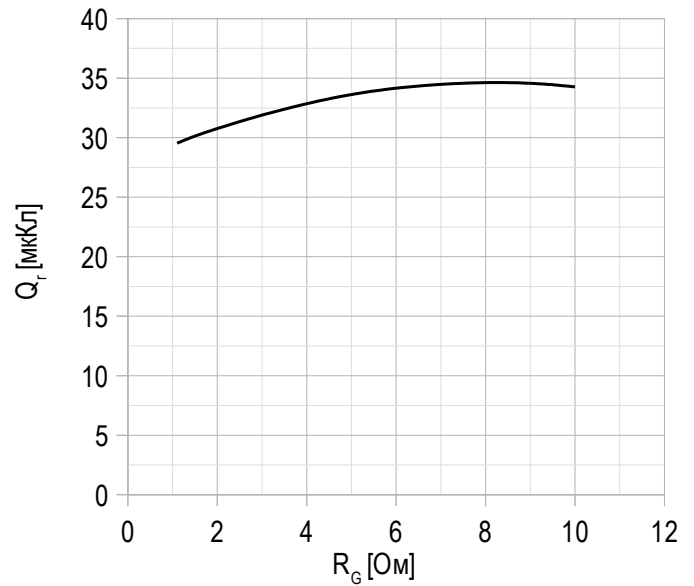
$U_{GE} = 0$  В.

**Рисунок 12 – типичная энергия рассеиваемая при восстановлении от тока коллектора, FRD.**


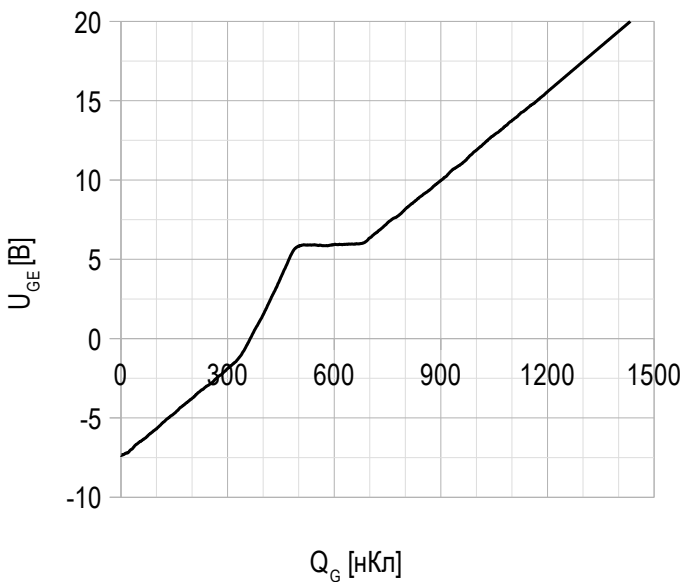
$U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $U_{CE} = 600$  В;  
 $L_s = 56$  нГн;  
 $R_{G\ on} = 2.2$  Ом;  
 $T_{vj\ (max)} = 150^\circ\text{C}$ .

**Рисунок 13 – типичная энергия рассеиваемая при восстановлении от сопротивления в затворе, FRD.**


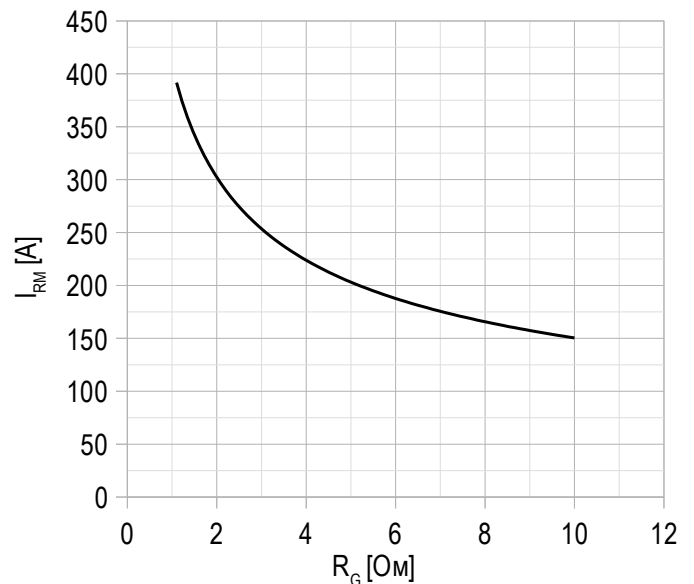
$U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $U_{CE} = 600$  В;  
 $I_C \max = 300$  А;  
 $L_s = 56$  нГн;  
 $T_{vj}(\max) = 150^\circ\text{C}$ .

**Рисунок 14 – типичная зависимость заряда обратного восстановления от сопротивления в затворе, FRD.**


$U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $U_{CE} = 600$  В;  
 $I_C \max = 300$  А;  
 $L_s = 56$  нГн;  
 $T_{vj}(\max) = 150^\circ\text{C}$ .

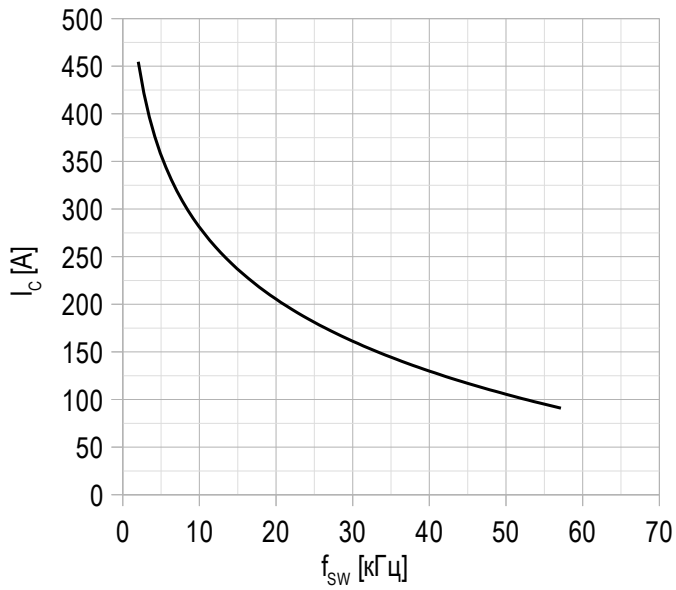
**Рисунок 15 – типичная характеристика заряда затвора.**


$I_C = 300$  А;  
 $U_{CE} = 600$  В;  
 $U_{GE} = -8 \div 15$  В.

**Рисунок 16 – типичная зависимость тока обратного восстановления от сопротивления в затворе, FRD.**


$U_{CE} = 600$  В;  
 $U_{GE} = \pm 15$  В;  
 $L_s = 56$  нГн.  
 $T_{vj}(\max) = 150^\circ\text{C}$ .

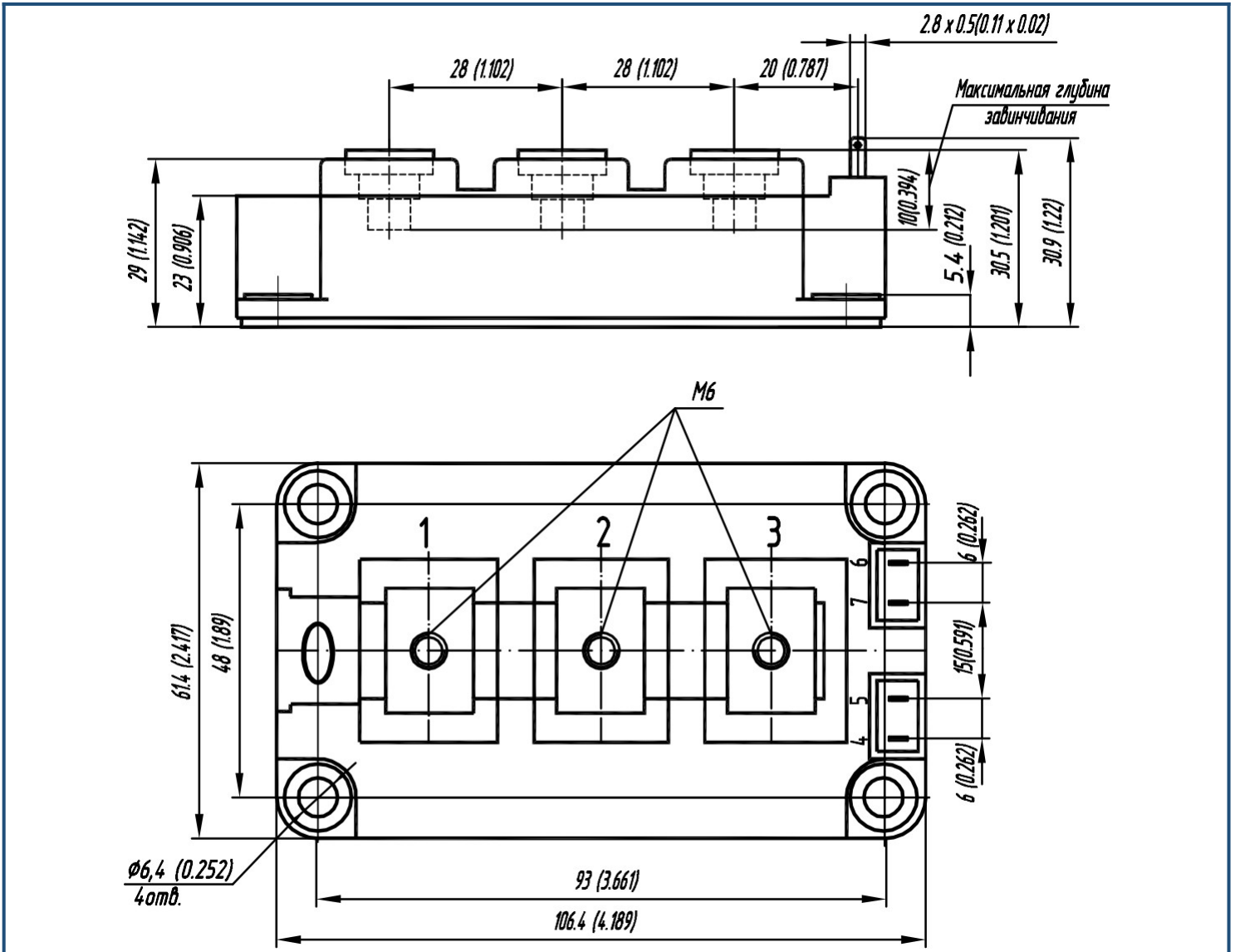
Рисунок 17 – максимальная зависимость тока коллектора от частоты.



Скважность 50%;  
 $U_{CE} = 600$  В;  
 $T_c = 80$  °С;  
 $T_{vj(max)} = 175$  °С.



Габаритные размеры: тип корпуса – AA


**Руководство по маркировке**

MIAA	-	HB	12	SA	-	300	N	
MIAA								Тип корпуса IGBT модуля: AA
		HB						2 ключа в схеме полумост
			12					Номинальное напряжение ( $U_{CES}/100$ )
				SA				IGBT+FRD модификация чипсета
						300		Средний ток
							N	Климатическое исполнение: умеренный климат

Информация, содержащаяся в данном документе, защищена авторским правом. В интересах улучшения качества продукта АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право вносить изменения в информационные листы без предварительного уведомления.